研究スタッフ

教 授: 大野 英男、 准教授: 大野 裕三
准教授: 松倉 文礼、 助 教: 大谷 啓太
研究員: 松坂 俊一郎、Mohsen Ghali

研究目的

本研究室では高機能・低消費電力スピンメモリ デバイスや量子コンピュータなどの量子情報処 理を目指して、固体中の電荷とスピンの両方の 自由度を用いたスピントロニクスの研究を行なっ ています。また、半導体量子構造中に形成され るサブバンドを用いた中赤外~テラヘルツ領域 の長波長半導体レーザに関する研究を行ってい ます。

1. 強磁性半導体

強磁性半導体は既存の半導体を構成する原子の一部を 磁性元素で置き換えた物質です。磁性元素はスピンを 持つだけでなく正孔を供給します。強磁性半導体の強 磁性状態は正孔の濃度に依存するため正孔の濃度を変 化させることで、磁性の性質を変えることができます。 本研究室では強磁性半導体を用いて、これまでに磁性 の電界制御や電気的手法による磁化反転、及び電流誘 起磁壁移動など新しいスピン機能デバイスに必要不可 欠な基盤技術を世界に先駆けて実現しています。





Appl. Phys. Lett. 69, 363 (1996); Science 281, 951 (1998).



大野・大野・松倉研究室

2. 半導体量子構造におけるスピンダイナミクス

量子コンピュータなどにスピンを応 用するためにはスピンを揃え、その ダイナミクスを理解し制御する必要 があります。本研究室では電子ス ピンの光学的な性質を利用して、 間接的に局所領域の核スピンの振 る舞いを調べる実験を行っていま す。例えば、円偏光のレーザ光に よって生成された電子スピンは、相 互作用によって量子井戸内の核ス ピンを偏極させることができます。 本研究室では、このような偏極状 態に置かれた核スピンを光学的、 磁気的に制御し、それを観測する ことに成功しました。



<u>非磁性半導体へのスピン注入</u>



また、強磁性半導体と非磁性半導体を組み合わせたスピンダイオー ドを作製し、スピンの揃った電子を 非磁性半導体へ流すことに成功し ました。

3. 量子カスケードレーザ

量子カスケードレーザは、発光に量子井戸内の準位間エネルギを利用するため、中赤外より 長波長の光を出すことが可能です。この波長領域には多くの化学物質の分子振動に起因す る吸収があるため、有害ガスなどを検出する小型光源として応用が期待されています。本研 究室ではInAs/AISbという独自の材料を用いて、これまでに波長3.8~14ミクロンでの発振に 成功しています。また、GaAs/AIGaAsを用いたTHz量子カスケードレーザの発振にも成功して います。



大野・大野・松倉研究室

www.ohno.riec.tohoku.ac.jp